（三）　分解能が一二ビット以上一四ビット未満のものであって、入力速度が一ギガサンプル毎秒を超えるもの
（四）　分解能が一四ビット以上一六ビット未満のものであって、入力速度が四〇〇メガサンプル毎秒を超えるもの
（五）　分解能が一六ビット以上のものであって、入力速度が一八〇メガサンプル毎秒を超えるもの
ロ　次のいずれかの機能を持つもの
（一）　デジタル化されたデータを出力するもの
（二）　デジタル化されたデータを記録するもの
（三）　デジタル化されたデータを解析するもの
十一　デジタル方式の記録装置であって、次のイ及びロに該当するもの
イ　ディスクメモリ又はソリッドステートドライブメモリへのデータ連続記録速度が六・四ギガビット毎秒を超えて維持可能なもの
ロ　記録中に無線周波数信号データを解析することができるプロセッサを有するもの
第六条第十三号ハ（二）中「合成出力周波数範囲」を「出力周波数範囲」に改め、同条第十七号ハを次のように改める。
ハ　削除
第六条第十七号ホ（一）中「イ、ロ又はハ」を「イ（一）から（三）まで又はロ（一）から（五）まで」に改め、同号ヘ（三）中「、半導体素子又は集積回路」及び「直接描画方式の」を削り、同号ヘ（三）1から3までを次のように改める。
1　照射面の半値全幅の直径が六五ナノメートル未満、かつ、イメージ位置誤差（平均値に三シグマを加えたもの）が一七ナノメートル未満のもの
2　削除
3　マスク上の二層目の重ね合わせ誤差（平均値に三シグマを加えたもの）が二三ナノメートル未満のもの
第六条第十七号ヘに次のように加える。
（四）　直接描画方式で半導体素子又は集積回路の製造をすることができるように設計した装置であって、電子ビームを用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
1　照射面の直径が一五ナノメートル以下のもの
2　重ね合わせ誤差（平均値に三シグマを加えたもの）が二七ナノメートル以下のもの
第七条第三号ハ及びホ中「八・〇実効テラ演算」を「一二・五実効テラ演算」に改め、同号トを次のように改める。
ト　削除
第八条第五号中「三一・八ギガヘルツを超える周波数で」を「次のいずれかで」に改め、同号に次のように加える。
イ　周波数が三一・八ギガヘルツ超五七ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力（ＥＲＰ）が二〇ディービーエム（等価等方輻射電力（ＥＩＲＰ）が二二・一五ディービーエム）以上のもの
ロ　周波数が五七ギガヘルツ超六六ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力（ＥＲＰ）が二四ディービーエム（等価等方輻射電力（ＥＩＲＰ）が二六・一五ディービーエム）以上のもの
ハ　周波数が六六ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力（ＥＲＰ）が二〇ディービーエム（等価等方輻射電力（ＥＩＲＰ）が二二・一五ディービーエム）以上のもの
ニ　周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの
第八条第八号の二イ（二）を次のように改める。
（二）　削除
第八条第八号の二ロ中「二五六値」を「一、〇二四値」に改め、同条第九号中「（次のへからツまでのいずれか、第三条第十九号ハ（二）2又は第十条第五号イに該当するものを除く。）」を削り、同号イ中「該当するもの」の下に「（へ若しくはリからツまでのいずれか、第三条第十九号ハ（二）2又は第十条第五号イに該当するものを除く。）」を加え、同号ロ中「設計したもの」の下に「（タ又はレに該当するものを除く。）」を加え、同号ハ中「二に」を「ニ、タ又はレに」に改め、同号ニ及びホ中「設計したもの」の下に「（タ又はレに該当するものを除く。）」を加え、同号ヨ中「ロ又は次号から第十二号までのいずれかに該当する機能を有していない装置」を「暗号装置」に改め、「又はハからホまでのいずれか」を削り、同号タ中「本号から第十二号まで」を「この号から第十号まで又は第十二号」に、「次号から第十二号まで」を「次号、第十号及び第十二号」に改め、同号レ中「次号から第十二号まで」を「次号、第十号及び第十二号」に改め、同条第九号の二中「第九号若しくは第十号から第十二号までのいずれか」を「前号イ」に改め、同条第十一号を次のように改める。
十一　削除
第八条第十三号中「第九号から前号まで」を「第九号から第十号まで又は前号」に改める。
第九条第一号イ（五）2中「一、〇〇〇メートル」の下に「以内」を加え、「信号を受信したときの位置精度の二乗平均」を「計測し、決定した位置の誤差の二乗平均平方根」に改め、同号イ（六）2中「五三〇メートル」の下に「以内」を加え、「距離における位置精度の二乗平均」を「距離にいる人を探知した場合の位置の誤差の二乗平均平方根」に改め、同号ロ（一）中「以下この号において同じ。」を削り、同条第三号ニ及びホ中「要素素子の数が一六以下のカプセル封じをした光導電セルであって硫化鉛又はセレン化鉛を用いたもの及び焦電検出器であって硫酸三グリシン、チタン酸ジルコン酸鉛にランタンを添加したもの、タンタル酸リチウム、ポリふっ化ビニリデン又はニオブ酸ストロンチウムバリウムを用いたものを除く。」を削り、同条第八号中「第十一条に該当するものを除く。）」を削り、同条第九号イ（二）及び（三）中「超えるもの」の下に「（太陽放射を追従するために地上に設置されたヘリオスタット用に設計した反射鏡を除く。）」を加え、同条第十号ロ（八）1二中「一〇ワット」を「三〇ワット」に、同号ロ（六）2二中「一〇ワット」を「五〇ワット」に改め、同号ニ（一）4一及び二のニ中「超えるもの」の下に「（エピタキシャル成長によって形成されたモノリシック型のものを除く。）」を加え、同条第十四号イ中「その精度の絶対値」を「その精度」に改める。
第十条第三号ハ中「機首方位精度が一秒当たり」を「機首方位精度が」に改める。
第十一条第四号ホを次のように改める。
ホ　潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計又は改造した水中用の観測装置であって、後方散乱による影響を減少させる機能を有するもの（レンジゲートイルミネーター又はレーザー発振器を使用した装置を含む。）
第十一条第五号を次のように改める。
五　水中用の照明装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ　ストロボ法を用いたものであって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもののうち、一秒間に五回を超えて発光することができるもの
ロ　アルゴンのアークを用いたものであって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの